

SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

一、 概述

74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行界出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用.(采用标准引脚。)移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发,如果这两个时钟连接在一起,移位寄存器始终在存储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。

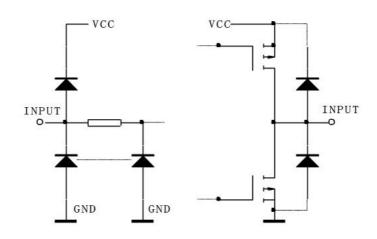
二、特性

- ▶ 高速率传输, 在VDD等于6V时最大数据传输速率可达59M。
- ▶ 低功耗,环境温度25℃时,Icc最大电流仅为4uA。
- ▶ 高抗扰度 VNIH = VNIL = 28% VCC (最小);
- ▶ 对称输出阻抗 |IOH| = IOL = 6mA (最小) 指AQ~QH端口; |IOH| = IOL = 4mA (最小)指QH'端口。
- ▶ 传播延迟平衡: tPLH tPHL。
- ▶ 宽范围工作电压,从 2V~6V。
- ▶ 脚位及功能与74系列之595完全兼容。

三、产品应用

▶ LED广告显示屏, LED数码屏等。

四、输入输出等效电路



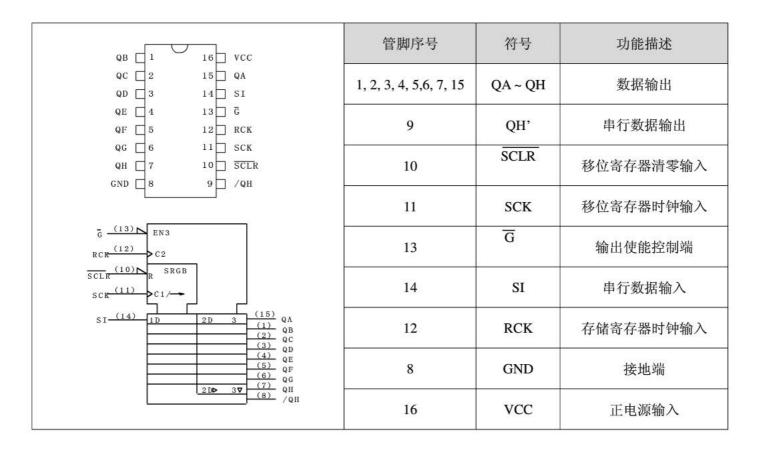


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

五、 脚位图与逻辑符号图



六、 真值表

		输入			输出
SI	SCK	SCLR	RCK	G	
X	X	X	X	Н	禁止 QA ~QH 输出
x	х	X	X	L	启动 QA ~QH 输出
X	Х	L	X	X	存储器复位
x		Н	X	X	在 SCK 的上升沿将数据储存到存储器里
x		Н	X	X	存储器状态不可改变
x	х	Х		X	在 RCK 的上升沿将数据储存到锁存器里
X	X	X	7_	X	锁存器的状态不可改变

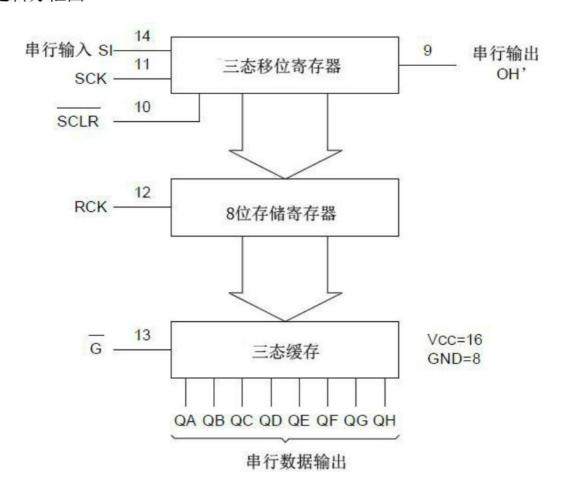


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

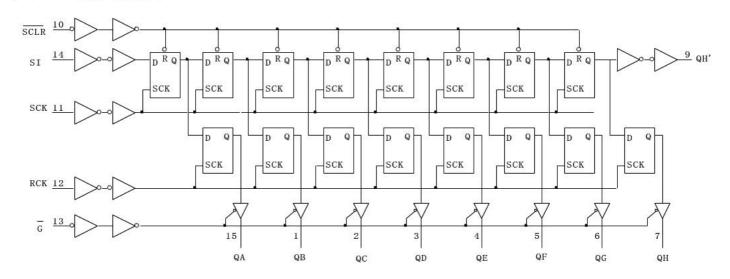
74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

七、逻辑方框图



八、 逻辑电路图



*此逻辑图不用作估算传播延时时间.

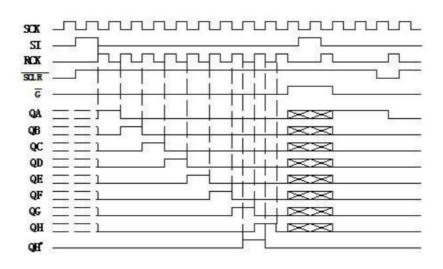


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

九、时序图



(注:) 此图表示高阻抗时段.

十、 最大额定值

符号	特性	参数值	单位			
Vcc	工作电压	-0.5 ~ +7	V			
Vl	直流输入电压	-0.5 ~Vcc+0.5	V			
Vo	直流输出电压	-0.5 ~Vcc+0.5	V			
Ilk	直流输正向输入	±20	mA			
Iok	直流正向输出	±20				
Io	直流输出电流	±35	mA			
Icc or I _{GND}	VCC 或 GND 电流	±70	mA			
Pd	功耗	500(*)	mW			
Tstg	储存温度	-65 ~+150	°C			
TL	焊接温度(10 秒)	300				

建议使用值

符号	特性	Ė	参数值	单位
Vcc	工作电压		2~6	V
Vl	输入电压		0~ Vcc	V
Vo	输出电压		0 ~Vcc	V
到p	工作温度	7786	-55 ~125	°C
		Vcc=2.0V	0 ~1000	ns
tr, tf	输入转变时间	Vcc=4.5V	0 ~ 500	ns
		Vcc=6.0V	0 ~ 400	ns



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

十一、 直流特性

			测试条件				测试值				
符号	特性	Vcc			T _A =25℃		-40 ~	85℃	-55 ~	125℃	单位
		(V)		最小值	典型值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
		2.0		1.5			1.5		1.5		
V_{IH}	高电平输入	4.5		3.15			3.15		3.15		V
		6.0		4.2			4.2		4.2		
		2.0				0.5		0.5		0.5	
V_{IL}	低电平输入	4.5				1.35		1.35	38	1.35	V
		6.0				1.8		1.8	ae	1.8	
		2.0	Io=-20uA	1.9	2.0		1.9		1.9		
	宣山亚松山	4.5	Io=-20uA	4.4	4.5		4.4		4.4		v
V_{OH}	高电平输出 (指 QH'端的输出)	6.0	Io=-20uA	5.9	6.0		5.9		5.9		
	(1月 (八 河口) 制 山)	4.5	Io=-6.0mA	4.18	4.31		4.13		4.10		
		6.0	Io=-7.8mA	5.68	5.8		5.63		5.60		
		2.0	Io=-20uA	1.9	2.0		1.9		1.9		
	高电平输出 (指 QA 到 QH 端)	4.5	Io=-20uA	4.4	4.5		4.4		4.4		
V_{OH}		6.0	Io=-20uA	5.9	6.0		5.9		5.9		v
		4.5	Io=-6.0mA	4.18	4.31		4.13		4.10		
		6.0	Io=-7.8mA	5.68	5.8		5.63		5.60		
		2.0	Io=20uA		0.0	0.1		0.1	× .	0.1	
	低由亚 松山	4.5	Io=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	
V_{OL}	低电平输出 (指 QH'端的输出)	6.0	Io=20uA		0.0	0.1		0.1		0.1	V
	(1月 Q几 河口和山)	4.5	Io=6.0mA		0.17	0.26		0.33	93	0.40	
		6.0	Io=7.8mA		0.18	0.26		0.33		0.40	
		2.0	Io=20uA		0.0	0.1		0.1	×	0.1	
	低电平输出	4.5	Io=20uA		0.0	0.1		0.1	66	0.1	
V_{OL}	低电干制出 (指 QA 到 QH 端)	6.0	Io=20uA		0.0	0.1		0.1	20.	0.1	V
	(相 QA 到 QII 埔)	4.5	Io=6.0mA		0.17	0.26		0.33		0.40	
		6.0	Io=7.8mA	-	0.18	0.26		0.33	e.	0.40	
I _I	输入漏电流	6.0	V1 = Vcc or GND			±0.1		±1		±1	uA
I_{OZ}	高阻抗输出漏电流	6.0	$Vl = V_{IH}$ or V_{IL} $Vo = Vcc$ or GND			±0.5		±5		±10	uA
I_{CC}	静态电流	6.0	V1 = Vcc or GND			4		40		80	uA



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

十二、 交流特性(CL=50pF,输入 $t_t=t_f=6ns$)

		测试	条件				测试值	3			ē.	
符号	限定特性	Vcc	C _L		5	T _A =25℃		-40 ~	85℃	-55 ~	125℃	单位
		(V)	(pF)		最小	典型	最大	最小	最大	最小	最大	
	(OA OII)	2.0				25	60		75		90	
$t_{TLH} t_{THL}$	(QA-QH)	4.5	50			7	12		15		18	ns
	输出转变时间	6.0				6	10		13		15	
	(COII)	2.0				30	75		95		115	
$t_{TLH} \; t_{THL}$	(SQH) 输出转变时间	4.5	50			8	15		19		23	ns
	棚山牧文町町	6.0				7	13		16		20	
	(SCK OII)/#	2.0				45	125		155		190	
$t_{PLH}\ t_{PHL}$	(SCK-QH')传播延时时间	4.5	50			15	25		31		38	ns
	1年7年17月1月	6.0				13	21		26		32	
	(SCI B OH')	2.0				60	175		220		265	
$t_{PLH}\ t_{PHL}$	(SCLR-QH') 传播延时时间	4.5	50			18	35		44		53	ns
	7を衝延的101円	6.0				15	30		37		45	
		2.0				60	150		190		225	
		4.5	50			20	30		38		45	ns
	(RCK-Qn)传播	6.0				17	26		32		38	
LPLH LPHL	PLH ^t PHL 延时时间	2.0				75	190		240		285	
		4.5	150			25	38		48		57	ns
		6.0				22	32		41		48	
		2.0				45	135		170		205	
		4.5	50	$R_L = 1K\Omega$		15	27		34		41	ns
t t	高阻抗输出开	6.0		,		13	23		29		35	
$t_{PZL} t_{PZH}$	启时间	2.0				60	175		220		265	
		4.5	150	$R_L = 1K\Omega$		20	35		44		53	ns
		6.0				17	30		37		45	
	高阻抗输出关	2.0				30	150		190		225	
$t_{PLZ}t_{PHZ}$	闭时间	4.5	50	$R_L = 1K\Omega$		15	30		38		45	ns
	Man Led	6.0				14	26		32		38	
		2.0			6.0	17		4.8		4		
		4.5	50		30	50		24		20		MHz
f_{MAX}	最高时钟频率	6.0			35	59		28		24		
1MAX	AKINIHI VI VX	2.0			5.2	14		4.2		3.4		
		4.5	150		26	40		21		17		MHz
		6.0			31	45		25		20		
terre	最小脉宽	2.0	50			17	75		95		110	ns
$t_{W(H)}$	(SCK, RCK)	4.5	30			6	15		19		22	115



SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		69				원 - 필리 (1982년 1982년 - 1982년	
		6.0		6	13	16	19	
		2.0		20	75	95	110	
$t_{W(L)}$	(SCLR)最小脉	4.5	50	6	15	19	22	ns
35000	宽	6.0		6	13	16	19	
	(SI-CCK)	2.0		25	50	65	75	
t_S	最小启动时间	4.5	50	5	10	13	15	ns
		6.0		4	9	11	13	
	(SCK DCK)	2.0		35	75	95	110	
t_S	(SCK-RCK)	4.5	50	8	15	19	22	ns
最小启动时间	6.0		6	13	16	19		
	(SCDI DCV)	2.0		40	100	125	145	
t_S	(SCRL-RCK) 最小启动时间	4.5	50	10	20	25	29	ns
	取小石纫时间	6.0		7	17	21	25	
		2.0			0	0	0	
t_h	最小维持时间	4.5	50		0	0	0	ns
		6.0			0	0	0	
		2.0		15	50	65	75	
t_{REM}	最小复位时间	4.5	50	3	10	13	15	ns
		6.0		3	9	11	13	

注: 启动时间指波形脉冲的启动时间.

十三、 输入电容特性

		测试条件		测试值							
符号	特性	Vcc		,	Γ _A =25°C	2	-40 ~	85°C	-55 ~	125℃	单位
		(V)		最小	典型	最大	最小	最大	最小	最大	
CIN	输入电容				5	10		10		10	皮法
CPD	功率耗散电容				184						皮法

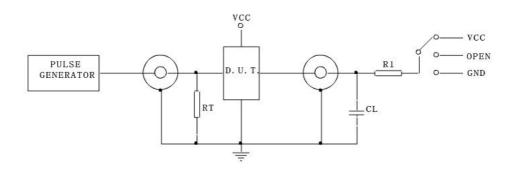


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

十四、测试电路



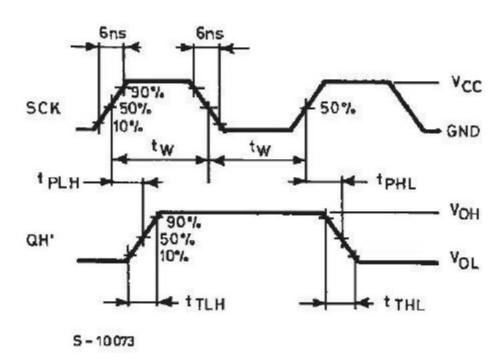
测试	转换
t _{PLH} t _{PHL}	开路
t _{PZL} t _{PLZ}	接电源正
t _{PZH} t _{PHZ}	接地

LC=50-150PF 或相当于此值的容量 (包含测试架与探针之分布电容)

R1=1KΩ 或相当于 1KΩ 的电阻值.

RT=脉冲产生器的 Zout. (典型值= 50Ω)

波形图 1: SCK ~ QH'的传播延时时间以及 SCK 的最小脉宽. (频率=1MHz;50%的占空比)



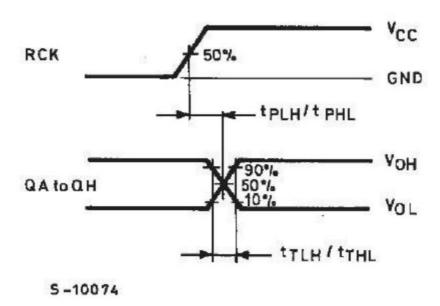


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

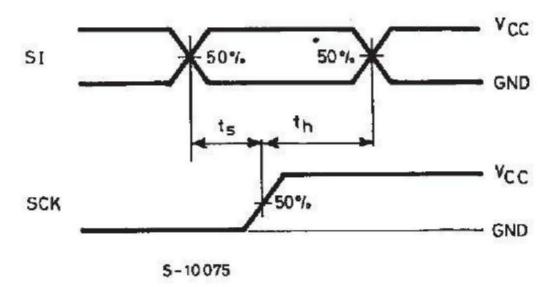
74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

波形图 2: RCK ~ Qn 的传播延时时间(频率=1MHz;50%的占空比)



波形图 3: SI~SCK 启动时间与持续时间(此启动时间指波形脉冲的启动时间)(频率=1MHz;50%的占空比)



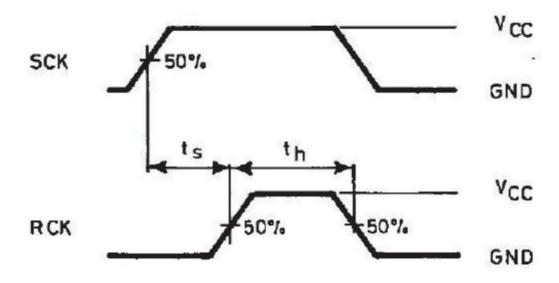


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

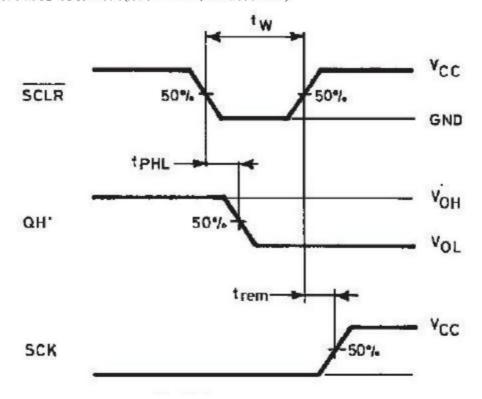
74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

波形图 4: SCK ~ RCK 启动时间与持续时间(此启动时间指波形脉冲的启动时间) (频率=1MHz;50%的占空比)



波形图 5: SCLR 最小脉宽与复位时间(频率=1MHz;50%的占空比)



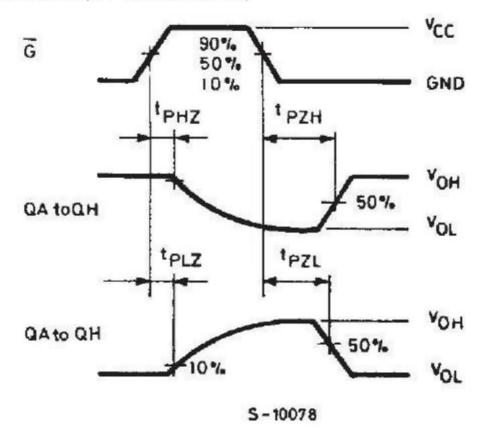


SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

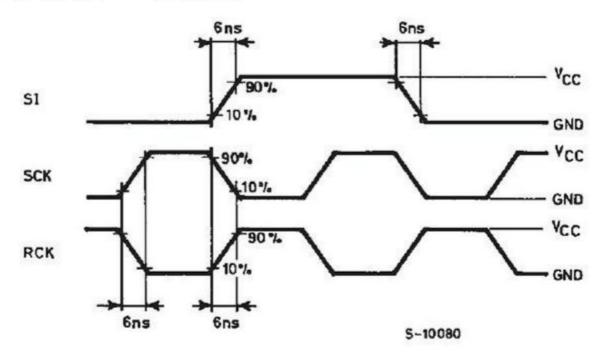
74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3态8位移位寄存器

波形图 6: 输出启动与关闭时间(频率=1MHz;50%的占空比)



波形图 7:输入波形 (频率=1MHz;50%的占空比)





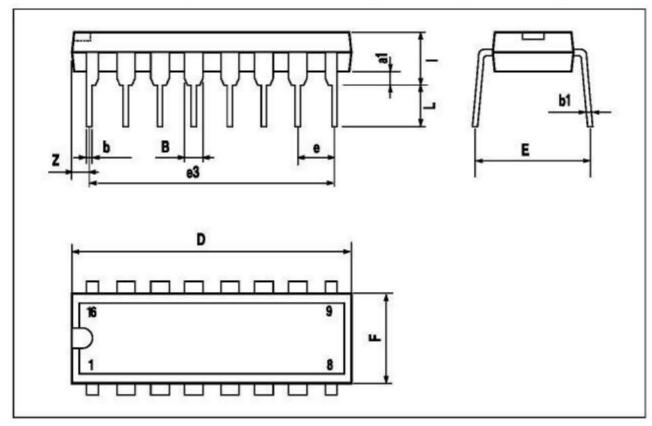
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

塑封 DIP-16 (0.25)尺寸参数

DIM		毫米		英寸					
DIM.	最小值	典型值	最大值.	最小值.	典型值.	最大值			
a1	0.51			0.020					
В	0.77		1.65	0.030		0.065			
b		0.5			0.020				
b1		0.25			0.010				
D			20			0.787			
E		8.5			0.335				
е		2.54			0.100				
e3		17.78			0.700				
F			7.1			0.280			
1			5.1			0.201			
L		3.3			0.130				
Z		1	1.27			0.050			





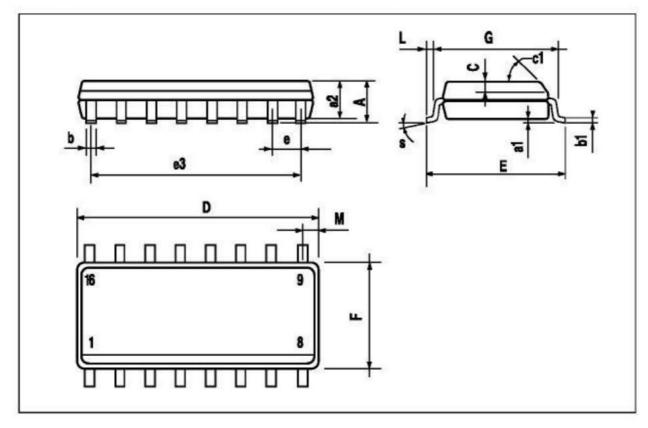
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

SO-16封装尺寸参数

DIM.		毫米			英寸				
DIM.	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值			
Α			1,75			0.068			
a1	0.1		0.2	0.003		0.007			
a2			1.65			0.064			
b	0.35		0.46	0.013		0.018			
b1	0.19		0.25	0.007		0.010			
С		0.5			0.019				
c1		•	45°	° (typ.)					
D	9.8		10	0.385		0.393			
E	5.8		6.2	0.228		0.244			
е		1.27			0.050				
e3		8.89			0.350				
F	3.8		4.0	0.149		0.157			
G	4.6		5.3	0.181		0.208			
L	0.5		1.27	0.019		0.050			
M			0.62			0.024			
S	-	•	8° (ı	max.)	HP.	10			





SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

74HC595(文件编号: S&CIC0501)

3 态 8 位移位寄存器

TSSOP16封装尺寸参数

DIM.		毫米		英寸				
DIWI.	最小值	典型值	最大值.	最小值	典型值	最大值		
Α	Į.		1.2			0.047		
A1	0.05		0.15	0.002	0.004	0.006		
A2	0.8	1	1.05	0.031	0.039	0.041		
b	0.19		0.30	0.007		0.012		
С	0.09		0.20	0.004		0.0089		
D	4.9	5	5.1	0.193	0.197	0.201		
E	6.2	6.4	6.6	0.244	0.252	0.260		
E1	4.3	4.4	4.48	0.169	0.173	0.176		
е		0.65 BSC			0.0256 BSC			
K	0°		8°	0°		8°		
L	0.45	0.60	0.75	0.018	0.024	0.030		

